

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 2000 мкм — техническое описание

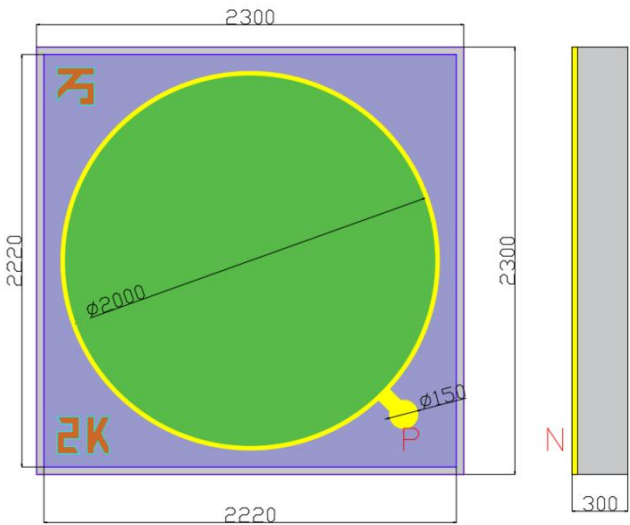
P/N : WIR3-2000

Особенности

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.
N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	-	2000	-	мкм
Ширина чипа	2250	2300	2350	мкм
Длина чипа	2250	2300	2350	мкм
Высота чипа	280	300	320	мкм
Размер контактной площадки	140	150	160	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-1V		5	25	нА
Напряжение обратного смещения	Vbr	Ir=-10μA	6	-	-	В
Чувствительность	R	Vr=0V,@1653 nm	0.9	0.95	-	А/Вт
Емкость	Cp	Vr=1V, f=1MHz		550	1000	пФ
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА

